



Technische Information / technical information



Netz-Thyristor Phase Control Thyristor

T501N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Key Parameters

$V_{\text{DRM}} / V_{\text{RRM}}$	6000V ... 7000V
I_{TAVM}	640A ($T_{\text{C}}=85^{\circ}\text{C}$)
I_{TSM}	13500A
V_{T0}	1,3V
r_{T}	1,35m Ω
R_{thJC}	17,0K/kW
Clamping Force	15 ... 24kN
Max. Diameter	76mm
Contact Diameter	50mm
Height	26mm



For type designation please refer to actual shortform catalog

<http://www.ifbip.com/catalog>

Merkmale

- Volle Sperrfähigkeit 50/60Hz über einen weiten Temperaturbereich
- Hohe DC Sperrstabilität
- Hohe Stoßstrombelastbarkeit
- Hoher Gehäusebruchstrom
- Hohe Einschalt di/dt Fähigkeit

Features

- Full blocking 50/60Hz over a wide range temperature range
- High DC blocking stability
- High surge current capability
- High case non-rupture current
- High di/dt capability

Typische Anwendungen

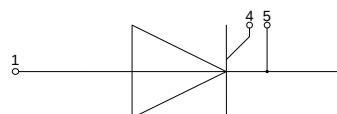
- Mittelspannungssanftanlasser
- Statische Kompensation SVC
- Gleichrichter für Antriebsapplikationen
- Lastgeführte Umrichter
- Kurzschließer-Applikationen

Typical Applications

- Medium Voltage Softstarter
- Static Var Compensation SVC
- Rectifier for Drives Applications
- Load Commutating Inverter
- Crowbar Applications



content of customer DMX code	DMX code digit	DMX code digit quantity
serial number	1..7	7
SP material number	8..16	9
datecode (production day)	17..18	2
datecode (production year)	19..20	2
datecode (production month)	21..22	2
vT class	23..26	4
QR class	27..30	4



www.ifbip.com
support@infineon-bip.com



Technische Information / technical information



Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Netz-Thyristor Phase Control Thyristor

T501N

Elektrische Eigenschaften / electrical properties Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	6000 V 6500 V 7000 V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$	I_{TRMSM}	1000 A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}$ $T_C = 70^{\circ}\text{C}$ $T_C = 55^{\circ}\text{C}$	I_{TAVM}	640 A 770 A 890 A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I_{TSM}	13500 A 13000 A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I^2t	910 $10^3\text{ A}^2\text{s}$ 845 $10^3\text{ A}^2\text{s}$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 60747-6 $f = 50\text{ Hz}, I_{\text{GM}} = 3\text{ A}, di_G/dt = 6\text{ A}/\mu\text{s}$	$(di_T/dt)_{\text{cr}}$	300 A/ μs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 5. Kennbuchstabe / 5 th letter H	$(dv_D/dt)_{\text{cr}}$	2000 V/ μs

Charakteristische Werte / characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_T = 1000\text{ A}$	V_T	typ. 2,55 V Max. 2,65 V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(\text{TO})}$	typ. 1,25 V max. 1,3 V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T	typ. 1,3 m Ω Max. 1,35 m Ω
Durchlaßkennlinie on-state characteristic $V_T = A + B \cdot I_T + C \cdot \ln(I_T + 1) + D \cdot \sqrt{I_T}$	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	typ. max.	A -0,0927 B 0,000967 C 0,1815 D 0,01334 A -0,0921 B 0,001 C 0,1841 D 0,0149
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 12\text{ V}$	I_{GT}	max. 350 mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 12\text{ V}$	V_{GT}	max. 2,5 V
Nicht zündender Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 12\text{ V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 0,5 V_{\text{DRM}}$	I_{GD}	max. 20 mA max. 10 mA
Nicht zündende Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_D = 0,5 V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max. 0,4 V
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 12\text{ V}$	I_{H}	max. 350 mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 12\text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10\text{ }\Omega$ $I_{\text{GM}} = 3\text{ A}, di_G/dt = 6\text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20\text{ }\mu\text{s}$	I_{L}	max. 3 A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$ $V_D = V_{\text{DRM}}, V_R = V_{\text{RRM}}$	I_D, I_R	max. 200 mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 60747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, I_{\text{GM}} = 3\text{ A}, di_G/dt = 6\text{ A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max. 2 μs

prepared by:	TM	date of publication:	2011-05-02
approved by:	JP	revision:	11.0



Technische Information / technical information



Netz-Thyristor Phase Control Thyristor

T501N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / electrical properties

Charakteristische Werte / characteristic values

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100\text{ V}$, $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{ V}/\mu\text{s}$, $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ 4. Kennbuchstabe / 4 th letter O	t_q	typ.	600	μs
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\max}$ $i_{TM} = I_{TAVM}$, $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8V_{RRM}$	Q_r	max.	7,2	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$T_{vj} = T_{vj\max}$ $i_{TM} = I_{TAVM}$, $-di_T/dt = 10\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 0,5V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8V_{RRM}$	I_{RM}	max.	210	A

Thermische Eigenschaften / thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ\sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max.	18,5	K/kW
			max.	17,0	K/kW
			max.	30,5	K/kW
			max.	38,5	K/kW
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	max.	5,0	K/kW
			max.	10,0	K/kW
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\max}$		125	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		-40...+125	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+150	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 4 page 4	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact					
Anpresskraft clamping force		F		15...24	kN
Steueranschlüsse control terminals	DIN 46244 Gate Kathode /Cathode			A 2,8x0,8 A 4,8x0,8	
Gewicht weight		G	typ.	550	g
Kriechstrecke creepage distance				25	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz			50	m/s ²



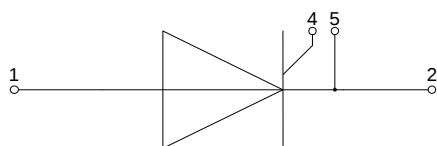
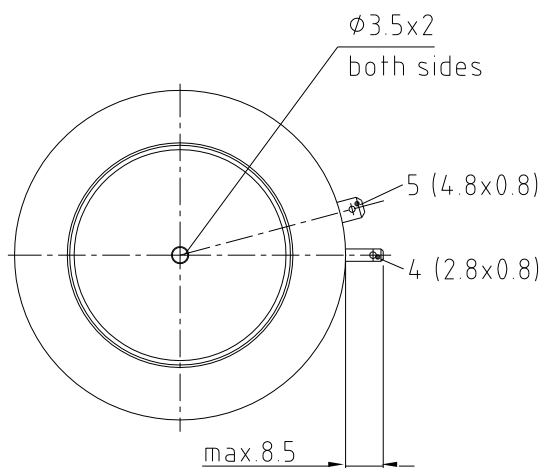
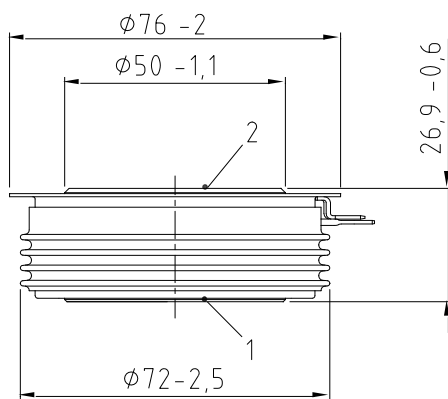
Technische Information / technical information



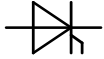
**Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor**

T501N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG



- 1: Anode/anode
- 2: Kathode/cathode
- 4: Gate
- 5: Hilfskathode/
cathode (control terminal)

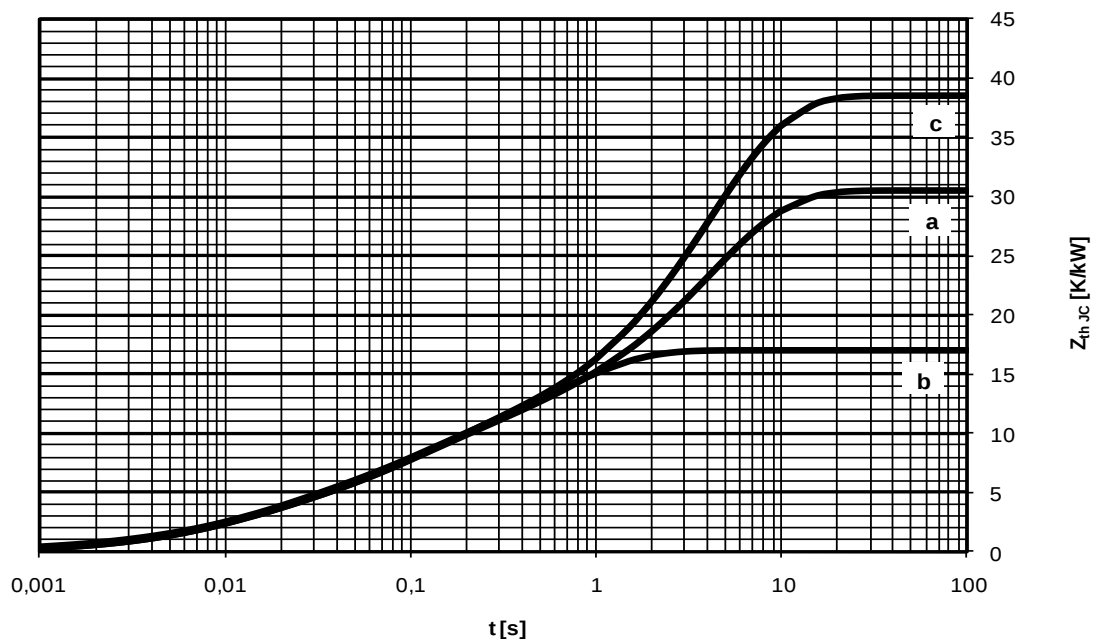


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} /
analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC}

	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [K/kW]	8,48	2,43	3,04	2,72	0,33		
	τ_n [s]	0,676	0,132	0,062	0,0134	0,0019		
anodenseitig anode-sided	R_{thn} [K/kW]	19,2	2,3	2,8	3,66	2,54		
	τ_n [s]	4,13	0,4	0,154	0,0607	0,0101		
kathodenseitig cathode-sided	R_{thn} [K/kW]	28,1	1,06	4,87	2,37	2,1		
	τ_n [s]	4,13	0,45	0,126	0,0374	0,0091		

Analytische Funktion / analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

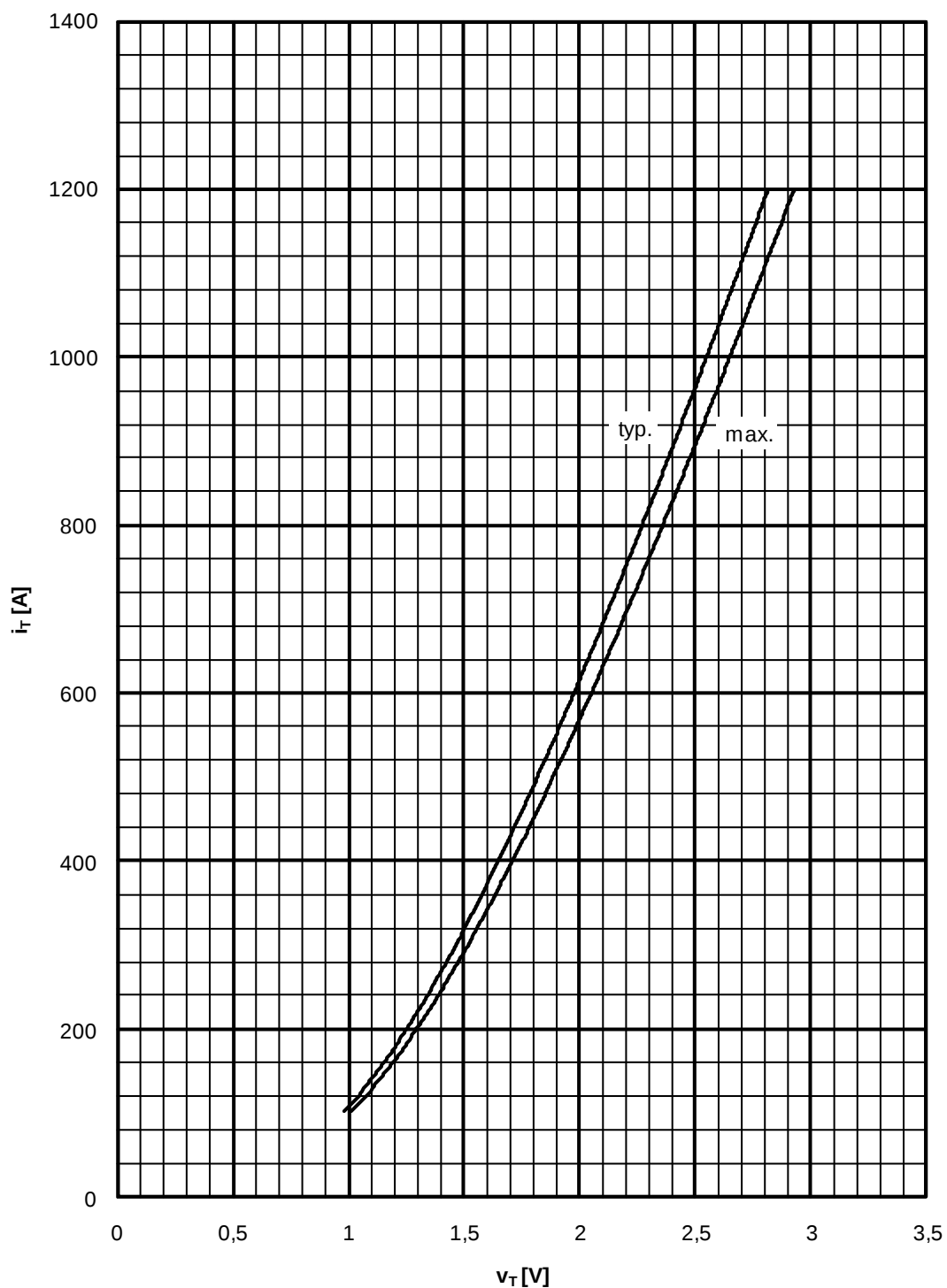


Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$ for DC

a : Anodenseitige Kühlung / anode-sided cooling

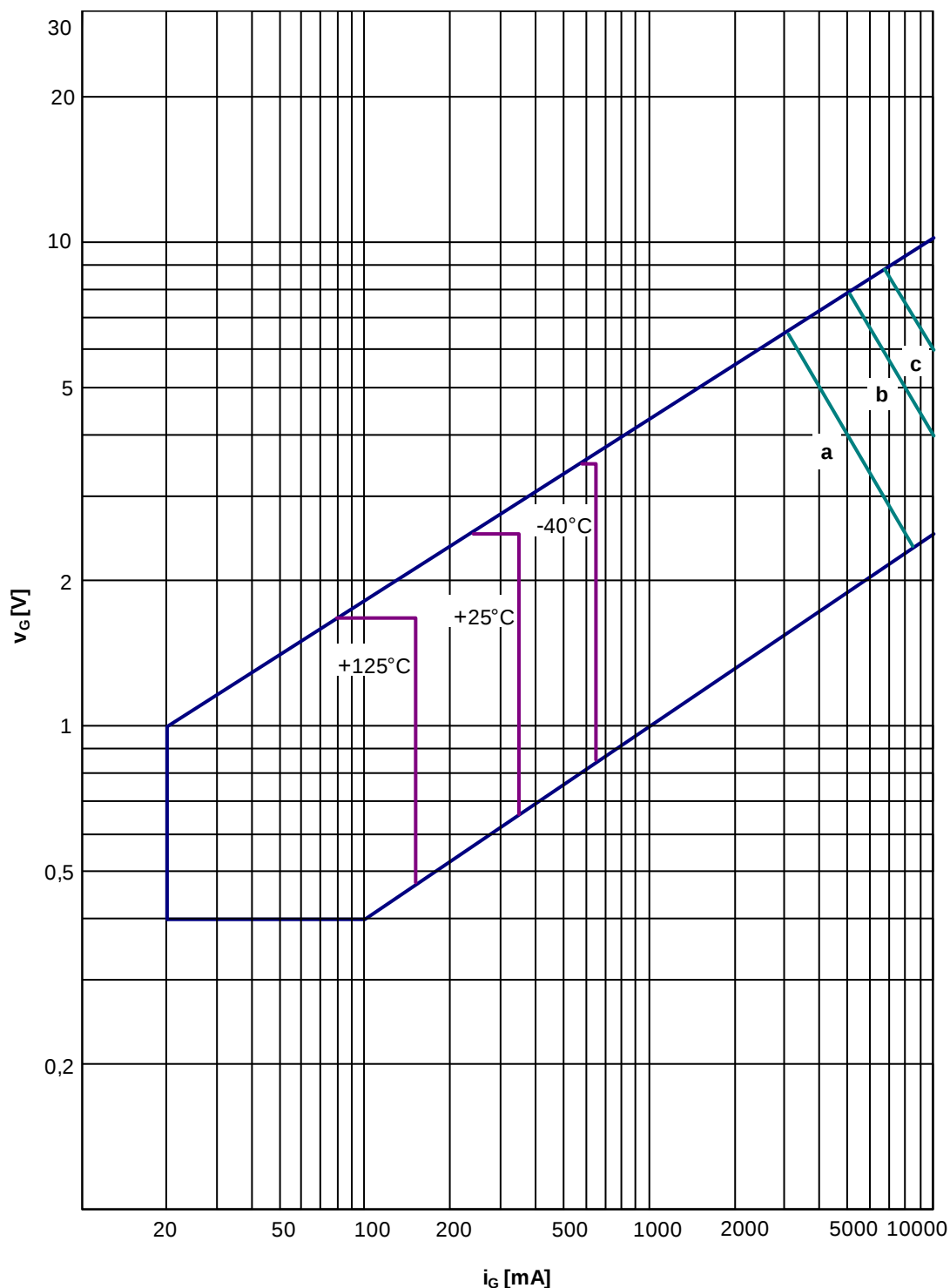
b : Beidseitige Kühlung / two-sided cooling

c : Kathodenseitige Kühlung / cathode-sided cooling



Grenzdurchlaßkennlinie / limiting on-state characteristic $i_T = f(v_T)$

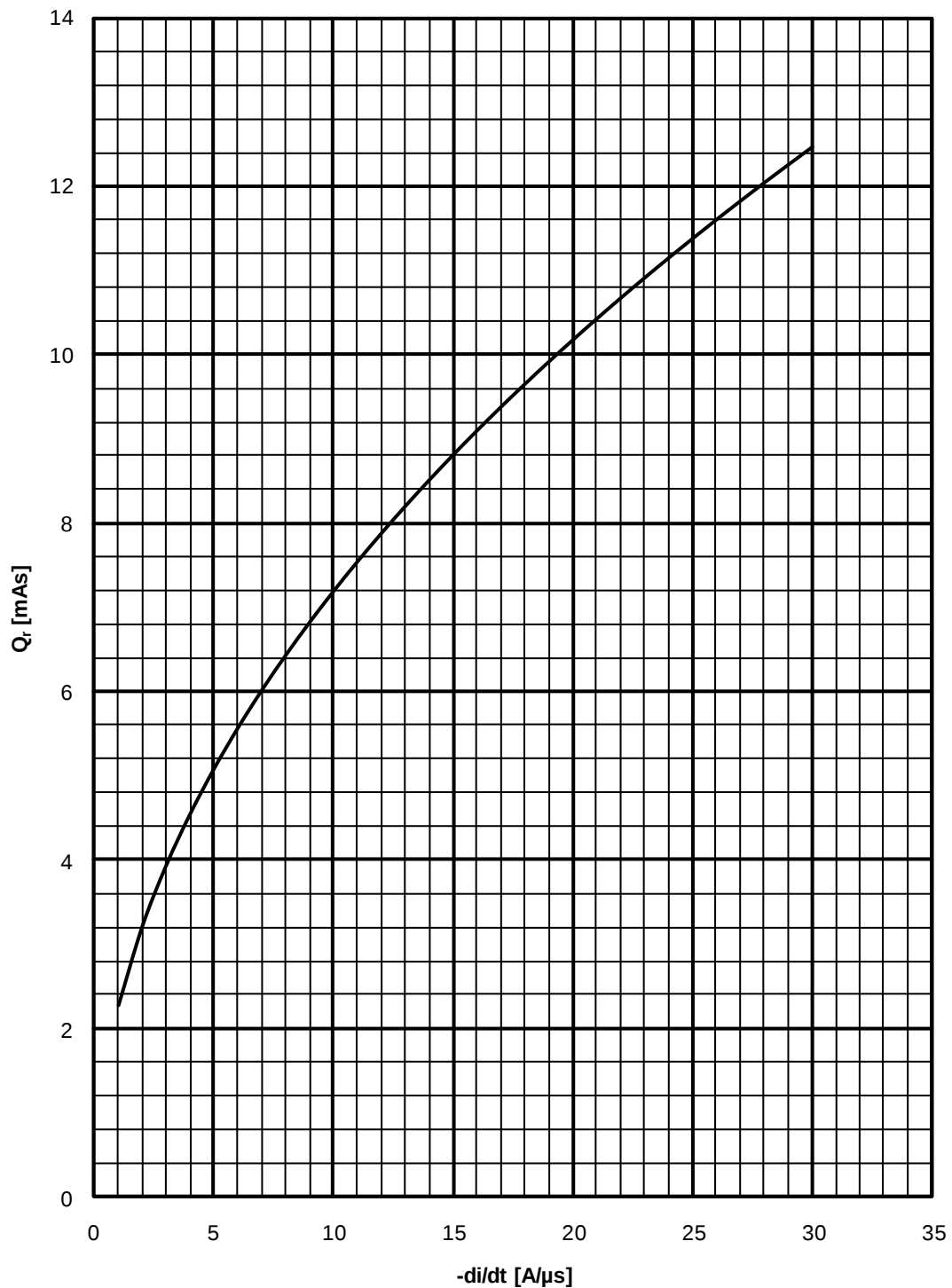
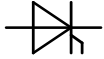
$$T_{vj} = T_{vj \max}$$



Steuercharakteristik $v_G = f(i_G)$ mit Zündbereichen für $V_D = 12$ V /
gate characteristic $v_G = f(i_G)$ with triggering area for $V_D = 12$ V

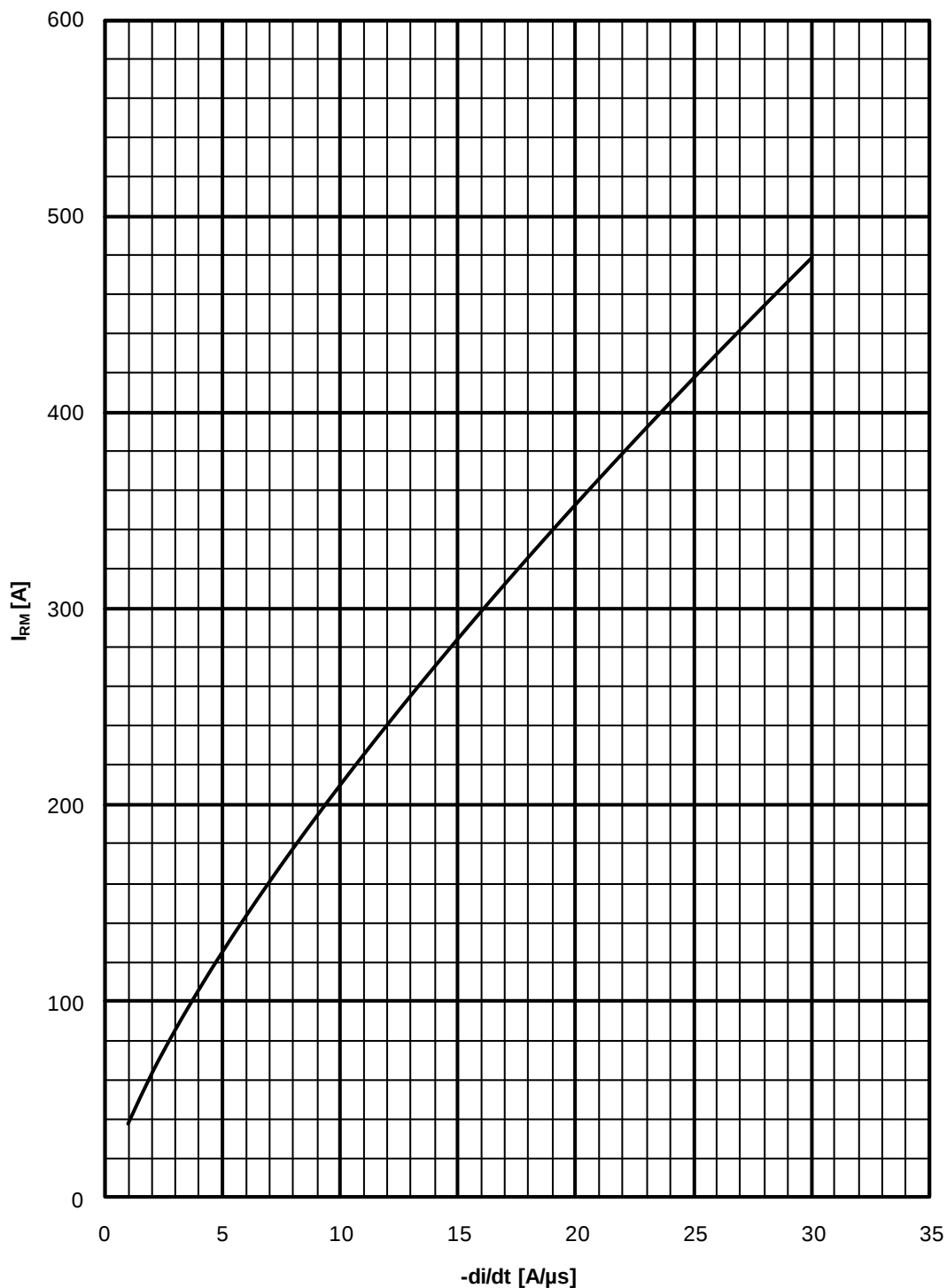
Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / maximum rated peak gate power dissipation $P_{GM} = f(t_g)$:

a - 20 W/10ms b - 40 W/1ms c - 60 W/0,5ms



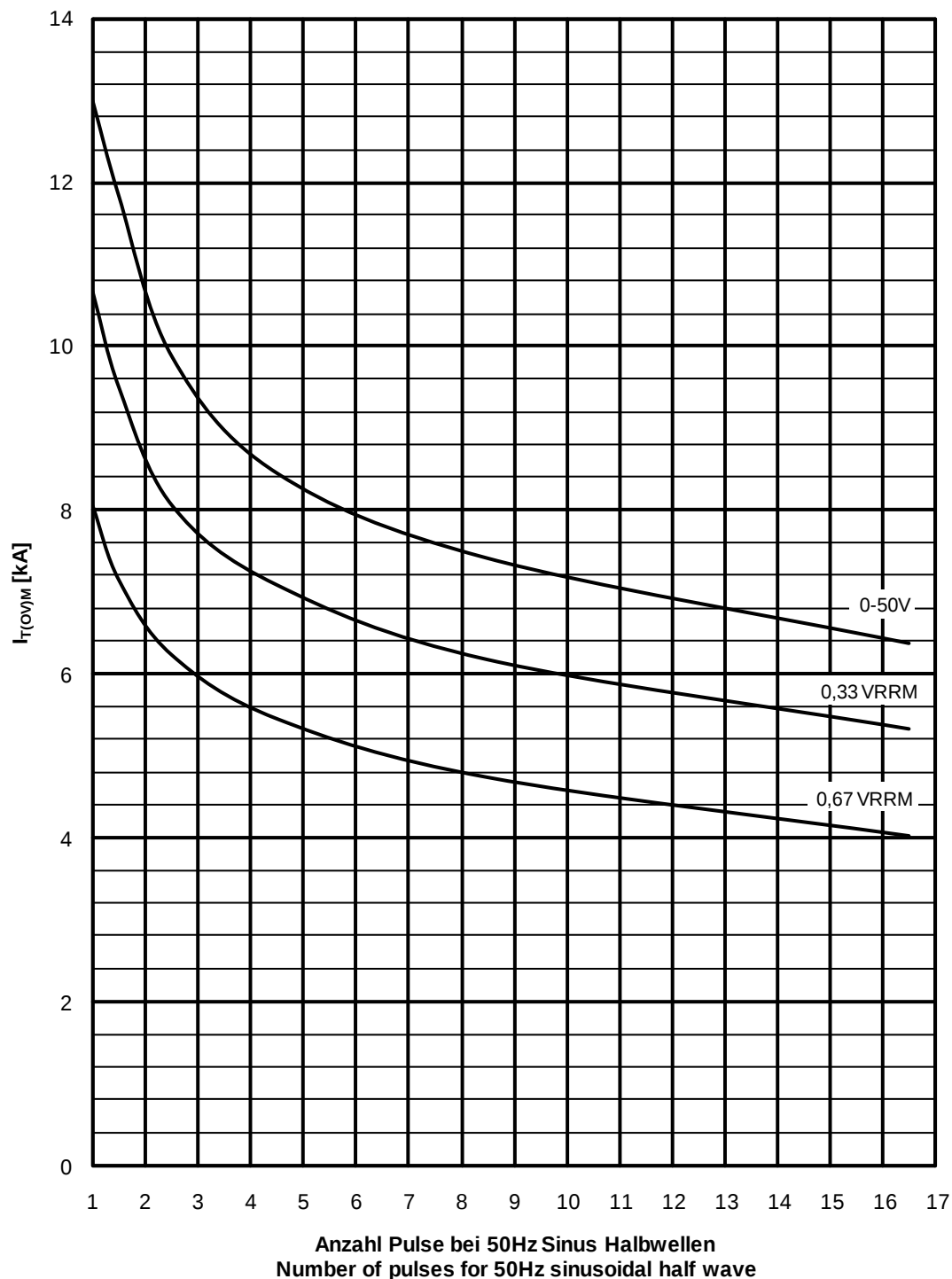
Sperrverzögerungsladung / recovered charge $Q_r = f(-di/dt)$

$T_{vj}=T_{vjmax}$, $v_R=0,5 V_{RRM}$, $V_{RM}=0,8 V_{RRM}$



Rückstromspitze / peak reverse recovery current $I_{RM} = f(-di/dt)$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $v_R = 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$



Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{T(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus Halbwellen bei 50Hz.

Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}

Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{T(OV)M}$ as a number of a sequence of sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}

$I_{T(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM})$; $T_{vj} = T_{vjmax}$



Technische Information / technical information



**Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor**

T501N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9